



4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

概述

MAX17505是高效、高压、同步整流降压型转换器，内置双MOSFET，工作在4.5V至60V输入电压范围。器件提供高达1.7A的输出电流，输出电压可在0.9V至90% V_{IN} 范围调节。内部补偿覆盖整个输出电压范围，无需外部元件。反馈(FB)调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.1%。器件采用紧凑的(4mm x 4mm) TQFN无铅(Pb)封装，带裸焊盘；提供仿真模型。

器件采用峰值电流工作模式，带MODE控制引脚，用于控制工作在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续传导模式(DCM)下。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率，在对开关频率敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲，以提高效率。DCM工作模式不采用跳脉冲，而是在轻载条件下禁止负向电感电流，在低于PFM模式电流的轻载条件下保持固定工作频率。DCM工作模式的效率介于PWM和PFM模式之间。内置低导通电阻MOSFET确保满载时高效工作，同时也简化了布局。

可编程软启动功能允许用户降低输入浪涌电流。器件还带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO)，允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。输出电压达到稳压范围时，经过一定延时后触发开漏RESET输出，为系统提供电源就绪指示。

应用

- 工业电源
- 配电电源
- 基站电源
- 墙上适配器
- 高压单板系统
- 通用负载点电源

优势和特性

- 无需外部元件，降低总体成本
 - 无需肖特基同步二极管即可保持高效、低成本工作
 - 内部补偿，在任意输出电压下均可稳定工作
 - 全陶瓷电容方案：超小尺寸布局，只需8个外部元件
- 缩减DC-DC稳压器库存清单
 - 4.5V至60V宽输入电压范围
 - 0.9V至90% V_{IN} 输出电压
 - 整个温度范围内可提供高达1.7A电流
 - 200kHz至2.2MHz可调节频率，带外同步
 - 采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装
- 降低功耗
 - 峰值效率高于90%
 - PFM和DCM模式，轻载时保持高效
 - 关断电流仅为2.8μA (典型值)
- 工作可靠
 - 打嗝式限流和自动重启
 - 内置输出电压监测(开漏RESET)
 - 电阻可编程EN/UVLO门限
 - 可调节软启动和预偏置上电
 - -40°C至+125°C工作温度范围

定购信息在数据资料的最后给出。

相关型号以及配合该器件使用的推荐产品，请参见：www.maximintegrated.com/MAX17505.related。

产品专利信息请参见：www.maximintegrated.com/products/patents。

本文是英文数据资料的译文，文中可能存在翻译上的不准确或错误。如需进一步确认，请在您的设计中参考英文资料。

有关价格、供货及订购信息，请联络Maxim亚洲销售中心：10800 852 1249 (北中国区)，10800 152 1249 (南中国区)，或访问Maxim的中文网站：www.maximintegrated.com/cn。

MAX17505

4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

Absolute Maximum Ratings

V_{IN} to PGND	-0.3V to +65V	LX Total RMS Current	±4A
EN/UVLO to SGND	-0.3V to +65V	Output Short-Circuit Duration	Continuous
LX to PGND	-0.3V to (V_{IN} + 0.3V)	Continuous Power Dissipation ($T_A = +70^\circ C$) (multilayer board)	
BST to PGND	-0.3V to +70V	TQFN (derate 30.3mW/ $^\circ C$ above $T_A = +70^\circ C$)	2424.2mW
BST to LX	-0.3V to +6.5V	Operating Temperature Range	-40°C to +125°C
BST to V_{CC}	-0.3V to +65V	Junction Temperature	+150°C
FB, CF, $\overline{\text{RESET}}$, SS, MODE, SYNC, RT to SGND	-0.3V to +6.5V	Storage Temperature Range	-65°C to +160°C
V_{CC} to SGND	-0.3V to +6.5V	Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C
SGND to PGND	-0.3V to +0.3V	Soldering Temperature (reflow)	+260°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

Package Thermal Characteristics (Note 1)

TQFN

- Junction-to-Ambient Thermal Resistance (θ_{JA}) 33°C/W
- Junction-to-Case Thermal Resistance (θ_{JC}) 2°C/W

Note 1: Package thermal resistances were obtained using the method described in JEDEC specification JESD51-7, using a four-layer board. For detailed information on package thermal considerations, refer to www.maximintegrated.com/cn/app-notes/index.mvp/id/4083.

Electrical Characteristics

($V_{IN} = V_{EN/UVLO} = 24V$, $R_{RT} = 40.2k\Omega$ (500kHz), $C_{VCC} = 2.2\mu F$, $V_{PGND} = V_{SGND} = V_{MODE} = V_{SYNC} = 0V$, $LX = SS = \overline{\text{RESET}} = \text{open}$, V_{BST} to $V_{LX} = 5V$, $V_{FB} = 1V$, $T_A = T_J = -40^\circ C$ to $+125^\circ C$, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$. All voltages are referenced to SGND, unless otherwise noted.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
INPUT SUPPLY (V_{IN})						
Input Voltage Range	V_{IN}		4.5	60		V
Input Shutdown Current	I_{IN-SH}	$V_{EN/UVLO} = 0V$ (shutdown mode)	2.8	4.5		μA
	I_{Q_PFM}	$V_{FB} = 1V$, MODE = RT = open	118			
	I_{Q_DCM}	$V_{FB} = 1V$, MODE = open	162			
Input Quiescent Current	I_{Q_DCM}	DCM mode, $V_{LX} = 0.1V$	1.16	1.8		mA
	I_{Q_PWM}	Normal switching mode, $f_{SW} = 500\text{kHz}$, $V_{FB} = 0.8V$	9.5			
ENABLE/UVLO (EN/UVLO)						
EN/UVLO Threshold	V_{ENR}	$V_{EN/UVLO}$ rising	1.19	1.215	1.24	V
	V_{ENF}	$V_{EN/UVLO}$ falling	1.068	1.09	1.111	
EN/UVLO Input Leakage Current	I_{EN}	$V_{EN/UVLO} = 0V$, $T_A = +25^\circ C$	-50	0	+50	nA
LDO						
V _{CC} Output Voltage Range	V_{CC}	6V < V_{IN} < 60V, $I_{VCC} = 1mA$	4.75	5	5.25	V
		1mA ≤ I_{VCC} ≤ 25mA				
V _{CC} Current Limit	$I_{VCC-MAX}$	$V_{CC} = 4.3V$, $V_{IN} = 6V$	26.5	54	100	mA
V _{CC} Dropout	V_{CC-DO}	$V_{IN} = 4.5V$, $I_{VCC} = 20mA$	4.2			V
V _{CC} UVLO	V_{CC_UVR}	V_{CC} rising	4.05	4.2	4.3	V
	V_{CC_UVF}	V_{CC} falling	3.65	3.8	3.9	

MAX17505

4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

Electrical Characteristics (continued)

($V_{IN} = V_{EN/UVLO} = 24V$, $R_{RT} = 40.2k\Omega$ (500kHz), $C_{VCC} = 2.2\mu F$, $V_{PGND} = V_{SGND} = V_{MODE} = V_{SYNC} = 0V$, $LX = SS = \overline{RESET} = \text{open}$, V_{BST} to $V_{LX} = 5V$, $V_{FB} = 1V$, $T_A = T_J = -40^\circ C$ to $+125^\circ C$, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$. All voltages are referenced to SGND, unless otherwise noted.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS		
POWER MOSFET AND BST DRIVER								
High-Side nMOS On-Resistance	R_{DS-ONH}	$I_{LX} = 0.3A$		165	325	$m\Omega$		
Low-Side nMOS On-Resistance	R_{DS-ONL}	$I_{LX} = 0.3A$		80	150	$m\Omega$		
LX Leakage Current	I_{LX_LKG}	$V_{LX} = V_{IN} - 1V$, $V_{LX} = V_{PGND} + 1V$, $T_A = +25^\circ C$	-2		+2	μA		
SOFT-START (SS)								
Charging Current	I_{SS}	$V_{SS} = 0.5V$	4.7	5	5.3	μA		
FEEDBACK (FB)								
FB Regulation Voltage	V_{FB_REG}	MODE = SGND or V_{CC}	0.89	0.9	0.91	V		
		MODE = OPEN	0.89	0.915	0.936			
FB Input Bias Current	I_{FB}	$0 < V_{FB} < 1V$, $T_A = +25^\circ C$	-50		+50	nA		
MODE								
MODE Threshold	V_{M-DCM}	MODE = V_{CC} (DCM mode)	$V_{CC} - 1.6$		V			
	V_{M-PFM}	MODE = open (PFM mode)	$V_{CC} / 2$					
	V_{M-PWM}	MODE = GND (PWM mode)	1.4					
CURRENT LIMIT								
Peak Current-Limit Threshold	$I_{PEAK-LIMIT}$		2.4	2.8	3.25	A		
Runaway Current-Limit Threshold	$I_{RUNAWAY-LIMIT}$		2.9	3.4	3.9	A		
Valley Current-Limit Threshold	$I_{SINK-LIMIT}$	MODE = open/ V_{CC}	-0.16	0	+0.16	A		
		MODE = GND	-1.8					
PFM Current-Limit Threshold	I_{PFM}	MODE = open	0.6	0.75	0.9	A		
RT AND SYNC								
Switching Frequency	f_{SW}	$R_{RT} = 102k\Omega$	180	200	220	kHz		
		$R_{RT} = 40.2k\Omega$	475	500	525			
		$R_{RT} = 8.06k\Omega$	1950	2200	2450			
		$R_{RT} = \text{open}$	460	500	540			
SYNC Frequency Capture Range		f_{SW} set by R_{RT}	1.1 x f_{SW}		1.4 x f_{SW}	kHz		

MAX17505

4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

Electrical Characteristics (continued)

($V_{IN} = V_{EN/UVLO} = 24V$, $R_{RT} = 40.2k\Omega$ (500kHz), $C_{VCC} = 2.2\mu F$, $V_{PGND} = V_{SGND} = V_{MODE} = V_{SYNC} = 0V$, $LX = SS = \overline{RESET} = \text{open}$, V_{BST} to $V_{LX} = 5V$, $V_{FB} = 1V$, $T_A = T_J = -40^\circ C$ to $+125^\circ C$, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$. All voltages are referenced to SGND, unless otherwise noted.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
SYNC Pulse Width			50			ns
SYNC Threshold	V_{IH}		2.1			V
	V_{IL}			0.8		
FB Undervoltage Trip Level to Cause Hiccup	$V_{FB-HICF}$		0.56	0.58	0.6	V
Hiccup Timeout		(Note 3)	32,768			Cycles
Minimum On-Time	t_{ON-MIN}			135		ns
Minimum Off-Time	$t_{OFF-MIN}$		140	160		ns
LX Dead Time			5			ns
RESET						
RESET Output Level Low		$I_{RESET} = 10mA$		0.4		V
RESET Output Leakage Current		$T_A = T_J = +25^\circ C$, $V_{RESET} = 5.5V$	-0.1		+0.1	μA
FB Threshold for \overline{RESET} Assertion	V_{FB-OKF}	V_{FB} falling	90.5	92	94	% V_{FB-REG}
FB Threshold for \overline{RESET} Deassertion	V_{FB-OKR}	V_{FB} rising	93.8	95	97.2	% V_{FB-REG}
RESET Deassertion Delay After FB Reaches 95% Regulation			1024			Cycles
THERMAL SHUTDOWN						
Thermal-Shutdown Threshold		Temperature rising	165			°C
Thermal-Shutdown Hysteresis			10			°C

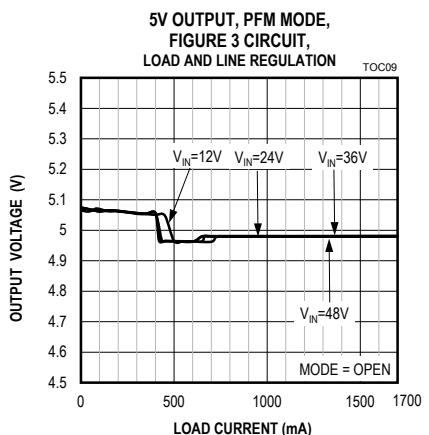
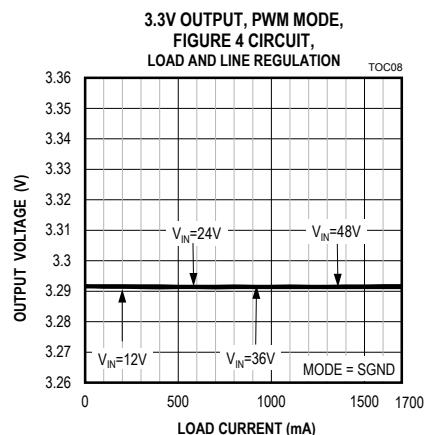
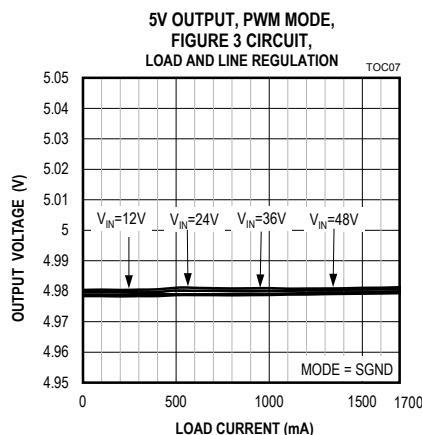
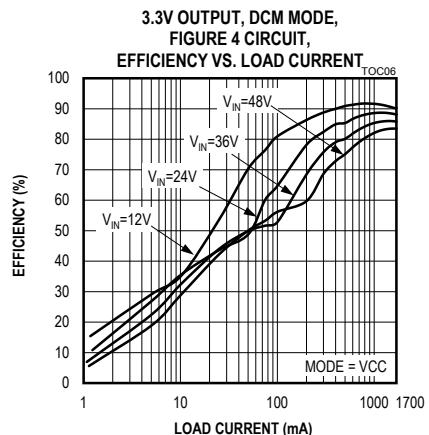
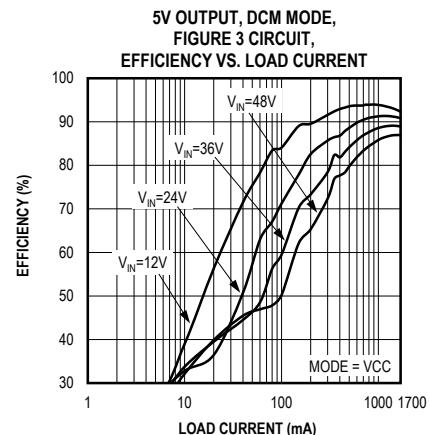
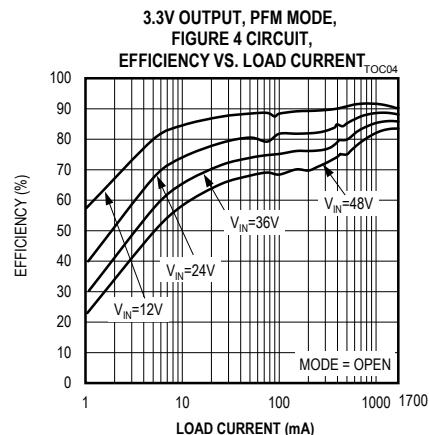
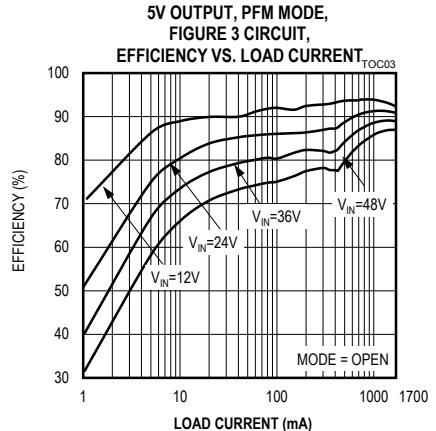
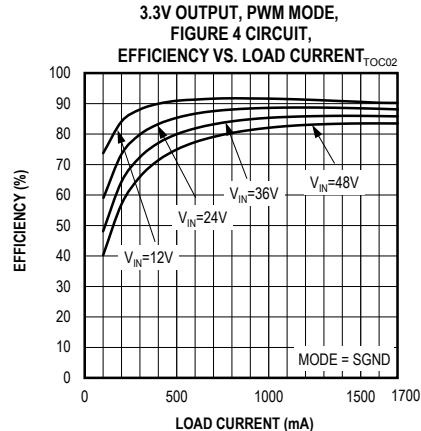
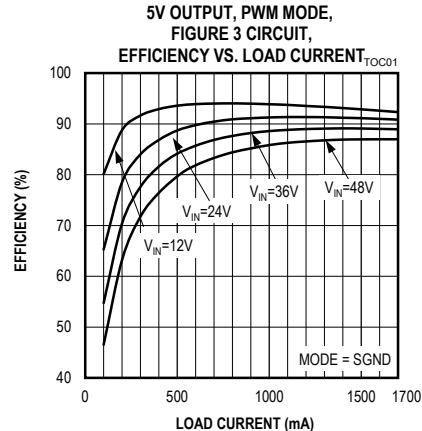
Note 2: All limits are 100% tested at $+25^\circ C$. Limits over temperature are guaranteed by design.

Note 3: See the [Overcurrent Protection/Hiccup Mode](#) section for more details.

4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

典型工作特性

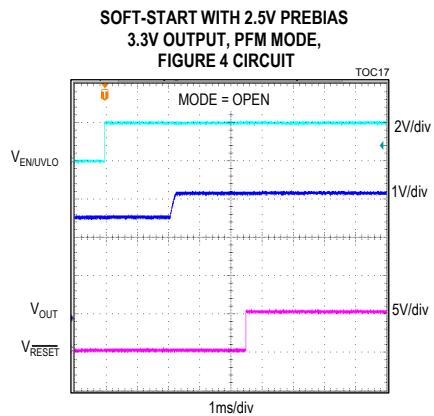
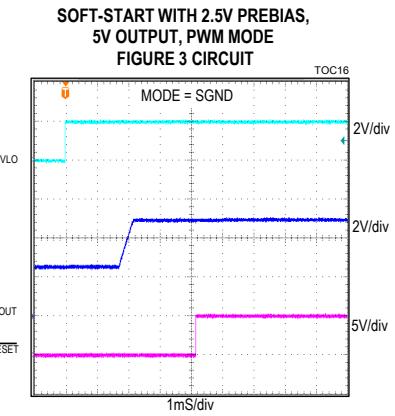
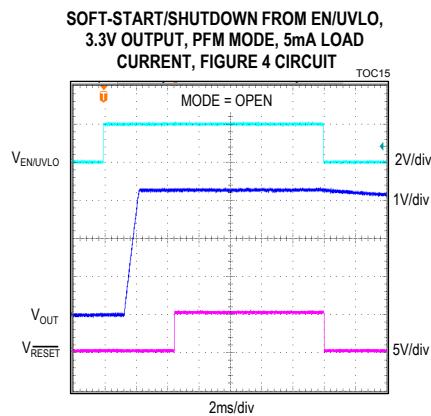
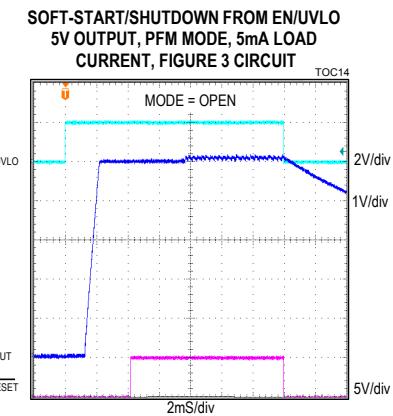
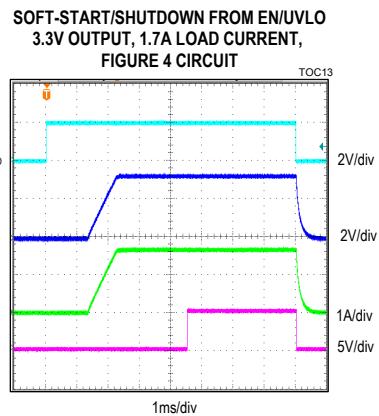
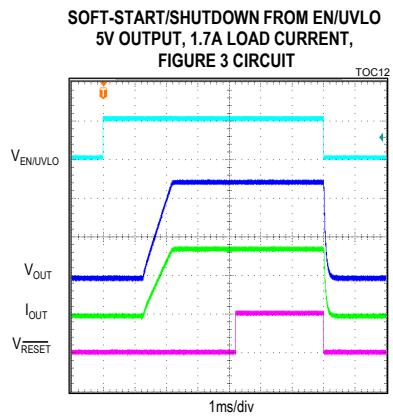
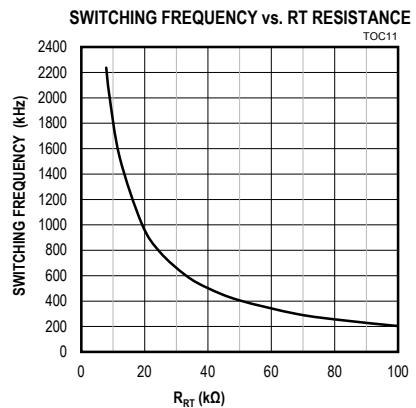
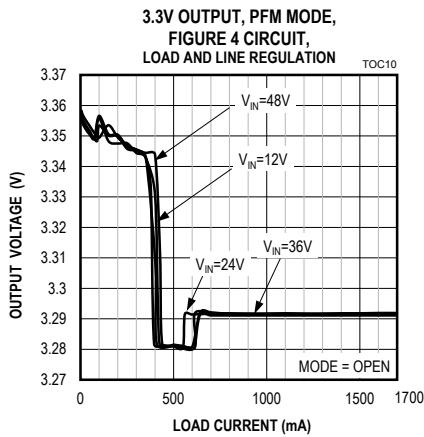
($V_{IN} = V_{EN/UVLO} = 24V$, $V_{PGND} = V_{SGND} = 0V$, $C_{VIN} = C_{VCC} = 2.2\mu F$, $C_{BST} = 0.1\mu F$, $C_{SS} = 5600pF$, $RT = MODE = open$, $T_A = T_J = -40^{\circ}C$ to $+125^{\circ}C$, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C$. All voltages are referenced to GND, unless otherwise noted.)



4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

典型工作特性(续)

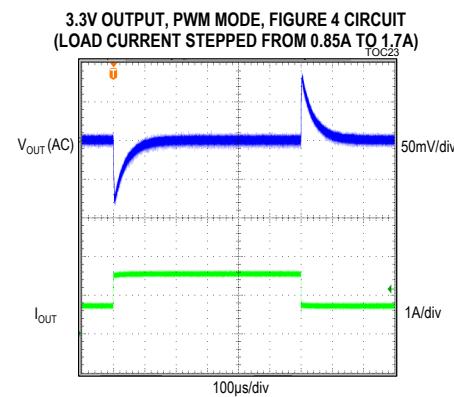
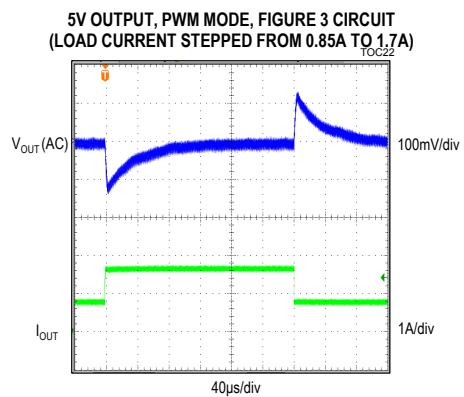
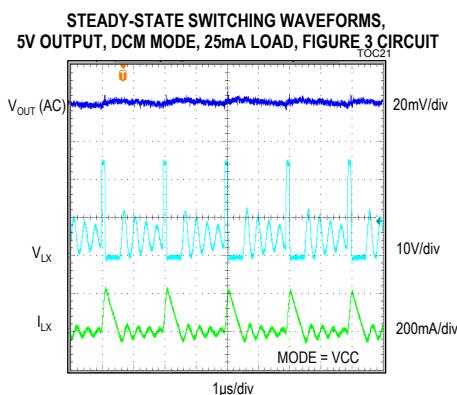
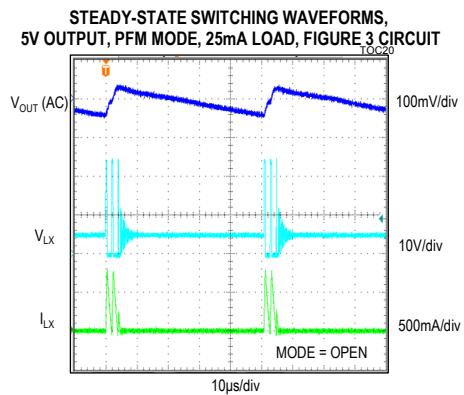
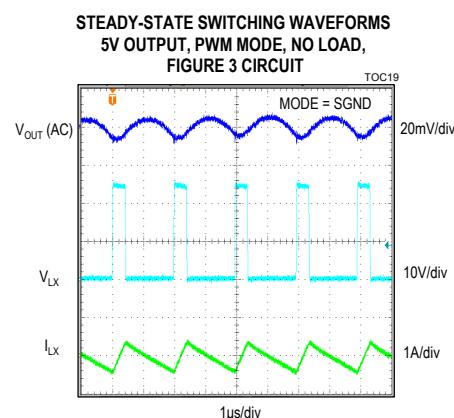
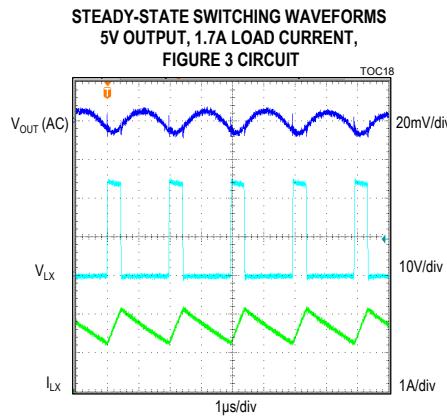
($V_{IN} = V_{EN/UVLO} = 24V$, $V_{PGND} = V_{SGND} = 0V$, $C_{VIN} = C_{VCC} = 2.2\mu F$, $C_{BST} = 0.1\mu F$, $C_{SS} = 5600pF$, $RT = MODE = open$, $T_A = T_J = -40^{\circ}C$ to $+125^{\circ}C$, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C$. All voltages are referenced to GND, unless otherwise noted.)



4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

典型工作特性(续)

($V_{IN} = V_{EN/UVLO} = 24V$, $V_{PGND} = V_{SGND} = 0V$, $C_{VIN} = C_{VCC} = 2.2\mu F$, $C_{BST} = 0.1\mu F$, $C_{SS} = 5600pF$, $RT = MODE = open$, $T_A = T_J = -40^{\circ}C$ to $+125^{\circ}C$, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C$. All voltages are referenced to GND, unless otherwise noted.)

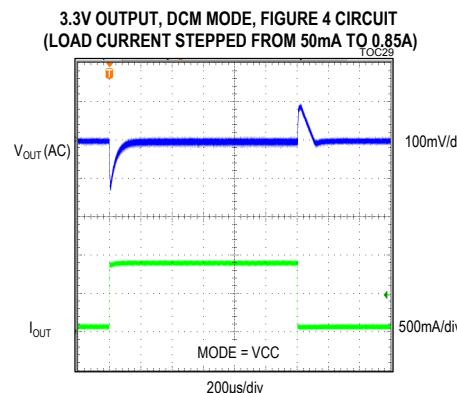
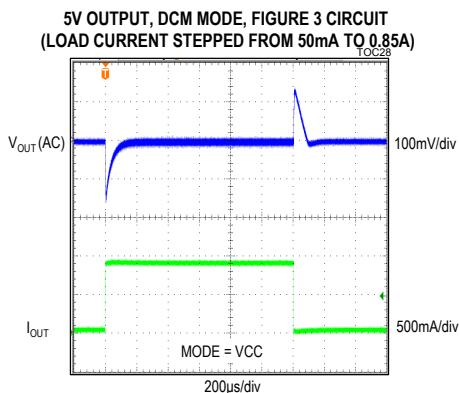
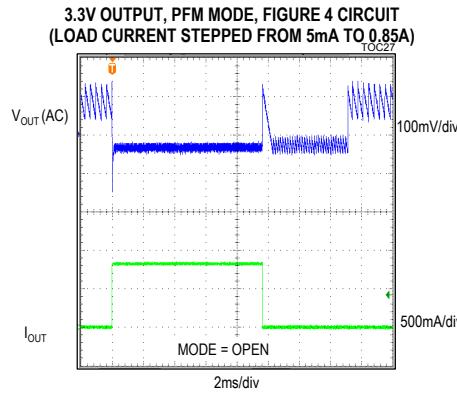
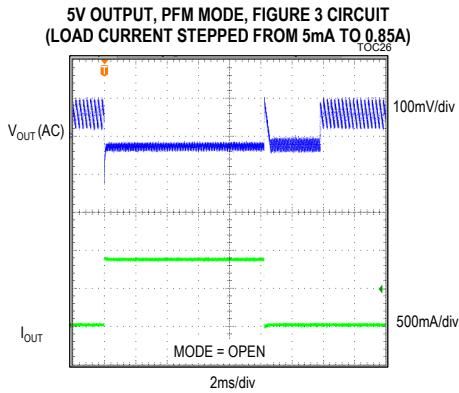
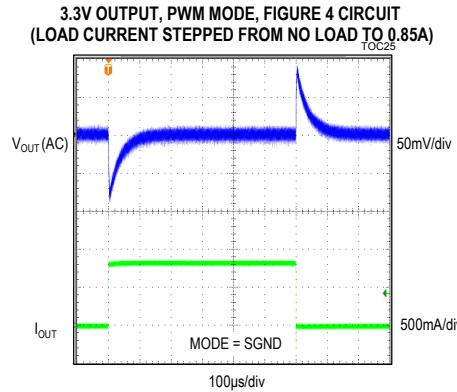
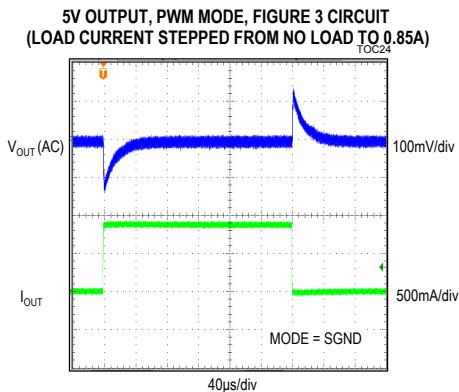


MAX17505

4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

典型工作特性(续)

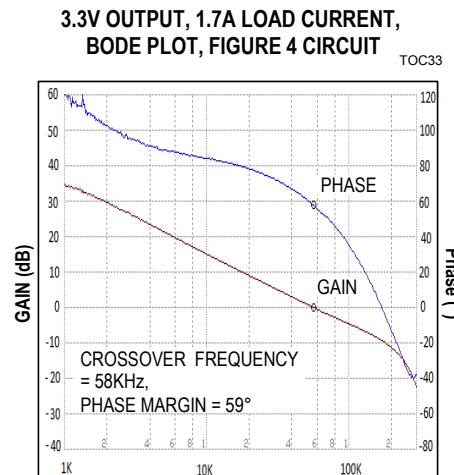
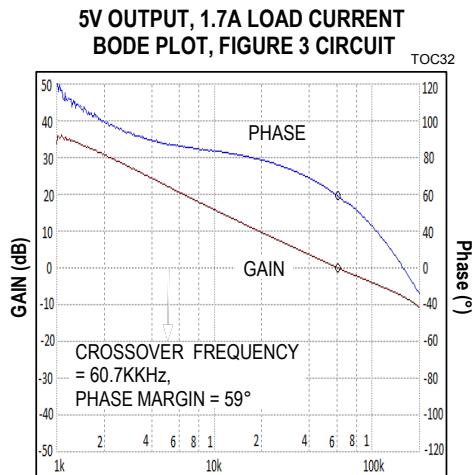
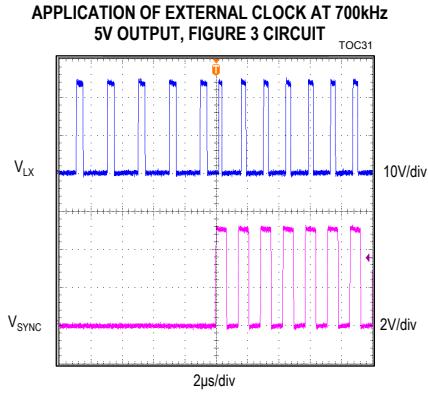
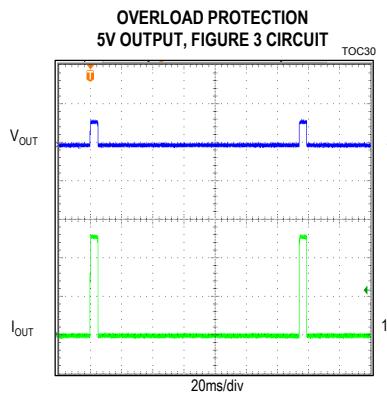
($V_{IN} = V_{EN/UVLO} = 24V$, $V_{PGND} = V_{SGND} = 0V$, $C_{VIN} = C_{VCC} = 2.2\mu F$, $C_{BST} = 0.1\mu F$, $C_{SS} = 5600pF$, $RT = MODE = open.$, $T_A = T_J = -40^{\circ}C$ to $+125^{\circ}C$, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C$. All voltages are referenced to GND, unless otherwise noted.)



4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

典型工作特性(续)

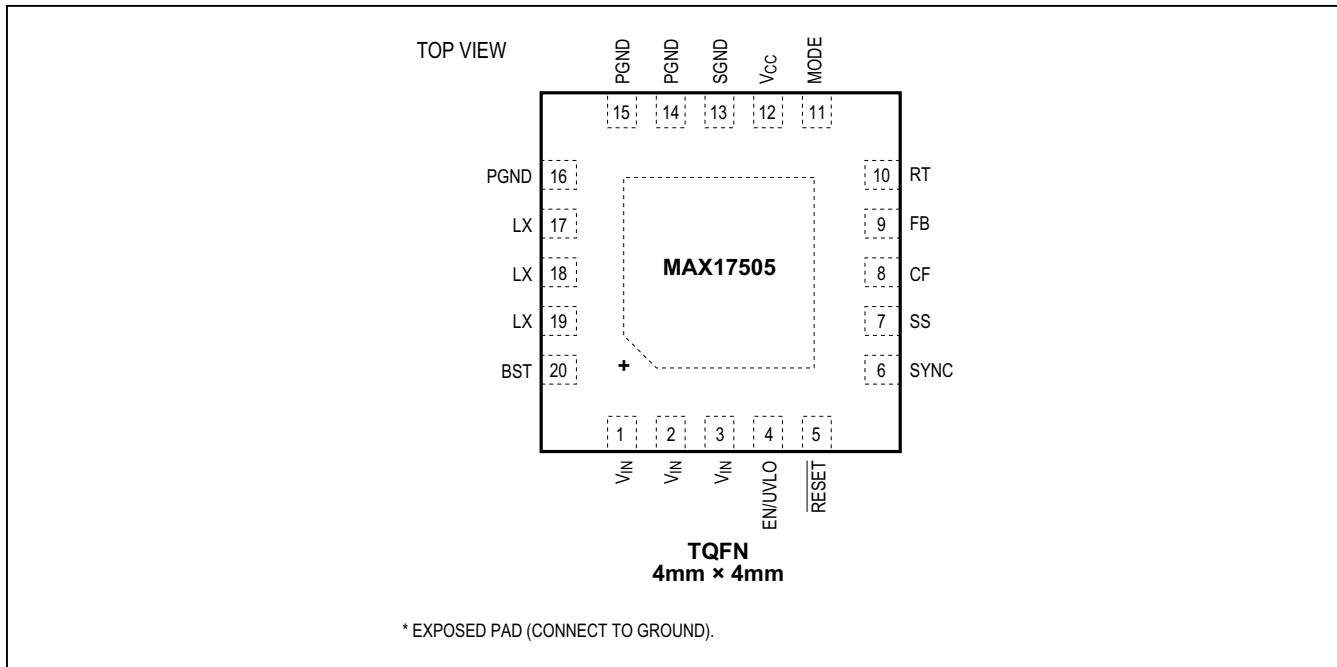
($V_{IN} = V_{EN/UVLO} = 24V$, $V_{PGND} = V_{SGND} = 0V$, $C_{VIN} = C_{VCC} = 2.2\mu F$, $C_{BST} = 0.1\mu F$, $C_{SS} = 5600pF$, $RT = MODE = open$, $T_A = T_J = -40^{\circ}C$ to $+125^{\circ}C$, unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C$. All voltages are referenced to GND, unless otherwise noted.)



MAX17505

4.5V-60V、1.7A、
高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

引脚配置



引脚说明

引脚	名称	功能
1-3	V _{IN}	电源输入，4.5V至60V输入电压范围。将V _{IN} 引脚连接在一起。利用2.2μF电容将该引脚连接至PGND，进行去耦；电容尽量靠近V _{IN} 和PGND引脚放置，布局示例请参考MAX17505评估板数据手册。
4	EN/UVLO	使能/欠压锁定。将EN/UVLO驱动至高电平时，使能输出；连接至V _{IN} 和GND之间的电阻分压器中心，用于设置输入电压检测门限，器件在输入达到该门限时开启。上拉至V _{IN} 时，器件始终开启。
5	RESET	开漏RESET输出。如果FB电压下降到稳压设置的92%以下，则将RESET输出拉至低电平；FB电压上升到设置稳压值的95%并保持1024个时钟周期后，RESET跳变为高电平。
6	SYNC	器件可利用该引脚与外部时钟同步，更多信息请参见外部时钟同步部分。
7	SS	软启动输入。在SS和SGND之间连接电容，用于设置软启动时间。
8	CF	开关频率低于500kHz时，在CF和FB之间连接电容；如果开关频率等于或高于500kHz，使CF保持开路。更多详细信息请参见环路补偿部分。
9	FB	反馈输入。将FB连接至输出与GND之间外部电阻分压器的中心抽头，用于设置输出电压。更多信息请参见调节输出电压部分。
10	RT	在RT和SGND之间连接电阻，设置稳压器的开关频率；使RT保持开路时，开关频率为默认500kHz。更多详细信息请参见设置开关频率(RT)部分。
11	MODE	MODE引脚用于将器件配置为PWM、PFM或DCM工作模式。MODE浮空时，为PFM工作模式(轻载时跳脉冲)；将MODE连接至SGND时，任何负载条件下均为固定频率PWM工作模式；将MODE连接至V _{CC} 时，为DCM工作模式。更多信息请参见MODE设置部分。

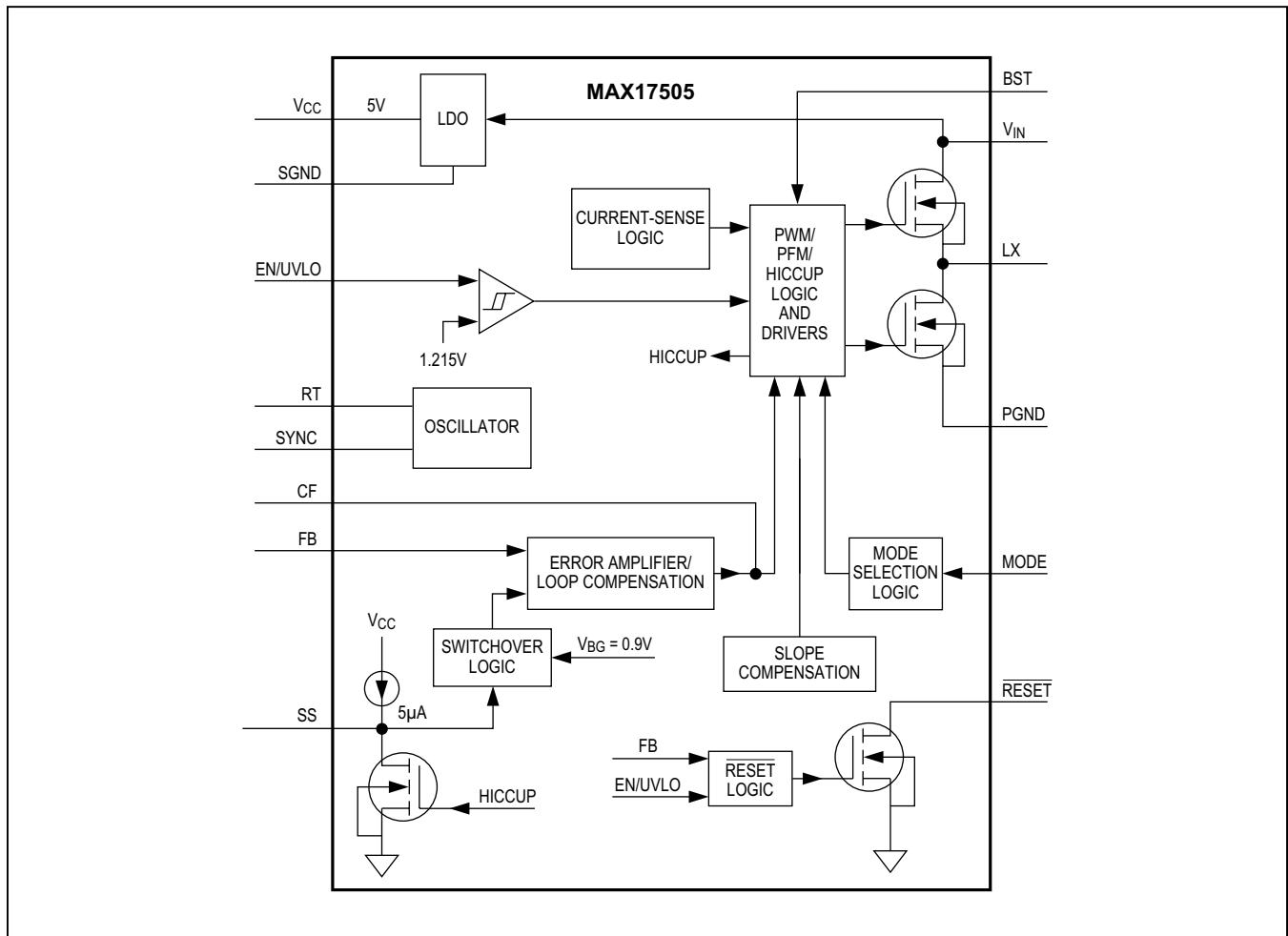
MAX17505

4.5V-60V、1.7A、
高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

引脚说明(续)

引脚	名称	功能
12	VCC	5V LDO输出。利用2.2μF陶瓷电容将VCC旁路至SGND。
13	SGND	模拟地。
14-16	PGND	功率地。在外部将PGND引脚连接至功率地。在VCC旁路电容接地回路中将SGND和PGND引脚连接在一起。布局示例请参考MAX17505评估板数据手册。
17-19	LX	开关节点。将LX引脚连接至电感的开关侧。布局示例请参考MAX17505评估板数据手册。
20	BST	自举电容。在BST和LX之间连接0.1μF陶瓷电容。
—	EP	裸焊盘，连接至SGND引脚。连接至IC下方较大的覆铜区域，以提高散热性能。在裸焊盘下方增加散热过孔。布局示例请参考MAX17505评估板数据手册。

方框图



4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

详细说明

MAX17505高效、高压、同步整流降压型转换器内置双MOSFET，工作在4.5V至60V输入电压范围。器件提供高达1.7A输出电流，输出电压可在0.9V至90% V_{IN} 范围调节。内置补偿覆盖整个输出电压范围，无需外部元件。反馈(FB)调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.1%。

器件采用峰值电流工作模式。内部跨导误差放大器在内部节点产生积分误差电压，误差电压通过PWM比较器、高边检流放大器和斜率补偿器设置占空比。在每个时钟的上升沿，高边MOSFET开启并保持导通，直到达到所要求的(或最大)占空比，或者是检测到峰值限流。高边MOSFET导通期间，电感电流线性上升。在开关周期的后半部分，高边MOSFET断开，低边MOSFET导通。电感电流下降的同时释放储能，为输出提供电流。

器件具有MODE引脚，用于控制器件工作在PWM、PFM或DCM模式。器件集成可调输入欠压锁定、可调软启动、开漏输出RESET以及外部时钟同步功能。

模式选择(MODE)

在 V_{CC} 和EN/UVLO电压超过相应UVLO上升门限，同时内部电压就绪、允许LX进行开关工作时，锁存MODE引脚的逻辑状态。如果MODE引脚在上电时开路，器件在轻载时工作在PFM模式；如果MODE引脚在上电时接地，器件在所有负载条件下工作在固定频率PWM模式；如果MODE引脚在上电时连接至 V_{CC} ，器件在轻载时工作在固定频率DCM模式。常规工作期间，忽略MODE引脚的状态变化。

PWM工作模式

PWM模式下，允许电感电流出现负值。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率工作，在对开关频率敏感的应用中非常有用。然而，相对于PFM和DCM工作模式，PWM模式在轻载条件下效率较低。

PFM工作模式

PFM工作模式可消除负向电感电流以及轻载下额外的跳脉冲，以获得较高效率。PFM模式下，每时钟周期的电感电流峰值强制为固定的750mA，直到输出上升到标称电压的102.3%。输出达到标称电压的102.3%后，关断高边和低边FET，器件进入深度休眠状态，直到负载将输出放电至标称电压的101.1%。深度休眠模式下，大部分内部电路关断，以节约静态电流。输出下降至标称电压的101.1%以下时，器件退出深度休眠模式，打开全部内部电路，再次以脉冲方式开始向输出传送能量，直到输出达到标称输出电压的102.3%。

PFM模式的优点是轻载时消耗的静态电流较低，所以效率较高；缺点是相对于PWM或DCM工作模式，输出电压纹波较高，轻载时开关频率不固定。

DCM工作模式

DCM工作模式不采用跳脉冲，而是在轻载条件下禁止负向电感电流，所以在低于PFM模式电流的轻载条件下采用固定工作频率。DCM工作模式的效率介于PWM和PFM模式之间。

线性稳压器(V_{CC})

内部线性稳压器(V_{CC})提供5V标称电压，为内部电路及低边MOSFET驱动器供电。应采用2.2μF陶瓷电容将线性稳压器的输出(V_{CC})旁路至SGND。器件采用欠压锁定电路， V_{CC} 下降至3.8V(典型值)以下时，关闭内部线性稳压器。

设置开关频率(RT)

器件的开关频率可利用RT和SGND之间的电阻设置，范围为200kHz至2.2MHz。开关频率(f_{SW})与RT引脚电阻(R_{RT})的关系如下式：

$$R_{RT} \cong \frac{21 \times 10^3}{f_{SW}} - 1.7$$

式中， R_{RT} 的单位为kΩ， f_{SW} 的单位为kHz。RT引脚开路时，器件工作在500kHz默认开关频率。关于几个常见开关频率对应的RT电阻值，请参见表1。

4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

表1. 开关频率与RT电阻

SWITCHING FREQUENCY (kHz)	RT RESISTOR (kΩ)
500	Open
200	102
400	49.9
1000	19.1
2200	8.06

输入电压工作范围

给定输出电压下的最小、最大输入电压计算如下：

$$V_{IN(MIN)} = \frac{V_{OUT} + (I_{OUT(MAX)} \times (R_{DCR} + 0.15))}{1 - (f_{SW(MAX)} \times t_{OFF(MAX)})} + (I_{OUT(MAX)} \times 0.175)$$

$$V_{IN(MAX)} = \frac{V_{OUT}}{f_{SW(MAX)} \times t_{ON(MIN)}}$$

式中， V_{OUT} 为稳态输出电压， $I_{OUT(MAX)}$ 为最大负载电流， R_{DCR} 为电感的直流电阻， $f_{SW(MAX)}$ 为最大开关频率， $t_{OFF-MAX}$ 为最差工作条件下的最小关断时间(160ns)， t_{ON-MIN} 为最差工作条件下的导通时间(135ns)。

外部时钟同步(SYNC)

器件的内部振荡器可同步至SYNC引脚的外部时钟信号。外同步时钟频率必须介于 $1.1 \times f_{SW}$ 至 $1.4 \times f_{SW}$ 之间，其中 f_{SW} 为RT电阻设定的频率。外部时钟脉宽为高电平的最长时间应大于50ns。详细信息请参见*Electrical Characteristics*表中的RT和SYNC部分。

过流保护/打嗝模式

器件具有可靠的过流保护机制，在过载和输出短路条件下有效保护器件。高边开关电流超过2.8A(典型值)时，逐周期峰值限流电路将断开高边MOSFET。高输入电压、短路条件(输出电压不足以恢复降压转换器导通期间建立的电感电流)下，高边开关3.4A(典型值)失控电流检测门限将为器件提供有效保护。一旦达到失控电流门限，则触发打嗝模式。此外，完成软启动后，如果反馈电压在任何时间因为故障条件而下降到0.58V(典型值)，同样触发打嗝模式。打嗝模式下，在超时周期(32,768个时钟周期)内暂停开关工作，保护转换器；达到打嗝超时周期后，再次尝试软启动。注意，当在过载条件下尝试软启动时，如果反馈电压未超过0.58V，器件以设定开关频率的一半进行开关操作。打嗝工作模式确保输出短路条件下保持低功耗。

RESET输出

器件包括RESET比较器，以监测输出电压。开漏RESET输出需要外部上拉电阻，稳压器输出升高至标称稳压值的95%以上，并保持1024个开关周期后，RESET跳变为高电平(高阻)。稳压器输出电压下降到标称稳压值的92%以下时，RESET跳变到低电平。热关断期间，RESET为低电平。

预偏置输出

当器件开始进入预偏置输出时，高边和低边开关均关断，转换器不会从输出吸入电流，直至PWM比较器触发第一个PWM脉冲时，高边和低边开关才开始工作；然后输出电压平稳上升，接近内部基准设置的目标电压。

热关断保护

热关断保护限制器件内部的总功耗。器件结温超过+165°C时，片上温度传感器关断器件，允许器件冷却。结温下降10°C后，温度传感器将器件再次打开。热关断期间，软启动复位。严格评估总体功耗(参见功率耗散部分)，以免在正常工作时意外触发热关断保护。

4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

应用信息

输入电容选择

输入滤波电容用于抑制电源的尖峰电流，减小电路开关工作引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流(I_{RMS})由下式确定：

$$I_{RMS} = I_{OUT(MAX)} \times \frac{\sqrt{V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT})}}{V_{IN}}$$

式中， $I_{OUT(MAX)}$ 为最大负载电流。输入电压等于输出电压的2倍时($V_{IN} = 2 \times V_{OUT}$)， I_{RMS} 值最大，此时 $I_{RMS(MAX)} = I_{OUT(MAX)}/2$ 。

所选电容在RMS输入电流下的温升应低于+10°C，以确保最佳长期稳定性。在输入端使用低ESR、可承受高纹波电流的陶瓷电容。工业应用中，为了保证温度稳定性，建议使用X7R电容。采用下式计算输入电容：

$$C_{IN} = \frac{I_{OUT(MAX)} \times D \times (1-D)}{\eta \times f_{SW} \times \Delta V_{IN}}$$

式中， $D = V_{OUT}/V_{IN}$ 为控制器的占空比， f_{SW} 为开关频率， ΔV_{IN} 为允许的输入电压纹波， η 为效率。

在电源距离器件输入较远的应用中，应该给陶瓷电容并联一个电解电容，在输入电源通路较长的情况下，能够抑制电源线电感和输入陶瓷电容引起的自激。

电感选择

为配合器件正常工作，必须限定电感的三个关键参数：电感值(L)、电感饱和电流(I_{SAT})和直流电阻(R_{DCR})。开关频率和输出电压决定电感值，关系如下：

$$L = \frac{V_{OUT}}{f_{SW}}$$

式中， V_{OUT} 和 f_{SW} 为标称值。选择电感值接近上式计算的电感值。

选择最接近计算值的低损耗电感，并且电感尺寸在可接受范围，直流电阻最低。电感饱和电流额定值(I_{SAT})必须足够高，以确保电流在峰值电流门限2.8A以上时才会发生饱和。

输出电容选择

工业应用中，考虑到温度稳定性的要求，X7R陶瓷输出电容为首选。输出电容的大小需要支持输出最大电流50%的负载跃变时，输出电压变化维持在3%。最小输出电容可计算如下：

$$C_{OUT} = \frac{1}{2} \times \frac{I_{STEP} \times t_{RESPONSE}}{\Delta V_{OUT}}$$

$$t_{RESPONSE} \equiv \left(\frac{0.33}{f_C} + \frac{1}{f_{SW}} \right)$$

式中， I_{STEP} 为负载电流步长， $t_{RESPONSE}$ 为控制器的响应时间， ΔV_{OUT} 为允许的输出电压偏差， f_C 为目标闭环交越频率， f_{SW} 为开关频率。如果开关频率小于或等于500kHz，选择 f_C 为 f_{SW} 的1/9；如果开关频率高于500kHz，选择 f_C 为55kHz。

软启动电容选择

器件采用可调软启动方法降低浪涌电流。在SS引脚和SGND之间连接外部电容，设置软启动时间。所选的输出电容(C_{SEL})和输出电压(V_{OUT})决定要求的最小软启动电容，关系如下：

$$C_{SS} \geq 28 \times 10^{-6} \times C_{SEL} \times V_{OUT}$$

软启动时间(t_{SS})与SS外部电容(C_{SS})的关系如下：

$$t_{SS} = \frac{C_{SS}}{5.55 \times 10^{-6}}$$

例如，为了实现1ms软启动时间，需在SS引脚和SGND之间连接5.6nF电容。

设置输入欠压锁定电平

器件提供可调节的输入欠压锁定电平。利用 V_{IN} 和SGND之间连接的电阻分压器设置器件的开启电压。将分压器的中间节点连接至EN/UVLO。

选择 R_1 为3.3MΩ，按下式计算 R_2 ：

$$R_2 = \frac{R_1 \times 1.215}{(V_{INU} - 1.215)}$$

式中， V_{INU} 为器件开启电压。应确保 V_{INU} 高于 $0.8 \times V_{OUT}$ 。

4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

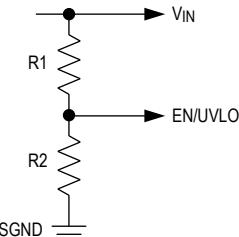


图1. 设置输入欠压锁定

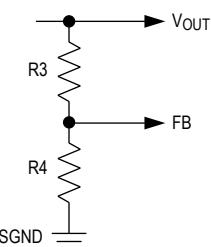


图2. 设置输出电压

表2. 不同开关频率对应的C6电容值

SWITCHING FREQUENCY RANGE (kHz)	C6 (pF)
200 to 300	2.2
300 to 400	1.2
400 to 500	0.75

环路补偿

器件具有内部环路补偿。然而，如果开关频率低于500kHz，在CF引脚和FB引脚之间连接0402电容C6。利用表2选择C6。

调节输出电压

利用输出电容(V_{OUT})正端与SGND之间连接的电阻分压器设置输出电压(见图2)。将分压器的中间节点连接至FB引脚。采用以下步骤选择分压电阻值：

利用下式计算输出与FB引脚之间的电阻R3：

$$R3 = \frac{216 \times 10^3}{f_C \times C_{OUT}}$$

式中，R3的单位为kΩ，交越频率f_C的单位为kHz，输出电容C_{OUT}的单位为μF。如果开关频率小于或等于500kHz，选择f_C为开关频率f_{SW}的1/9；如果开关频率高于500kHz，选择f_C为55kHz。

利用下式计算FB引脚与SGND之间的电阻R4：

$$R4 = \frac{R3 \times 0.9}{(V_{OUT} - 0.9)}$$

功率耗散

应确保器件结温在规定电源工作条件下不超过+125°C。

特定工作条件下，按下式估算导致器件温度升高的功耗：

$$P_{LOSS} = (P_{OUT} \times (\frac{1}{\eta} - 1)) - (I_{OUT}^2 \times R_{DCR})$$

$$P_{OUT} = V_{OUT} \times I_{OUT}$$

式中，P_{OUT}为输出功率，η为电源转换效率，R_{DCR}为输出电感的直流电阻(关于典型工作条件下效率的更多信息，请参见典型工作特性部分)。

对于多层电路板，封装的热性能参数由下式给出：

$$\theta_{JA} = 33^\circ\text{C/W}$$

$$\theta_{JC} = 2^\circ\text{C/W}$$

可利用下式估算器件在任意给定最大环境温度(T_{A_MAX})下的结温：

$$T_{J_MAX} = T_{A_MAX} + (\theta_{JA} \times P_{LOSS})$$

如果热管理系统提供适当散热，则可确保器件的裸焊盘维持在给定温度(T_{EP_MAX})，可利用下式估算最大环境温度下的结温：

$$T_{J_MAX} = T_{EP_MAX} + (\theta_{JC} \times P_{LOSS})$$

4.5V-60V、1.7A、 高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

PCB布局指南

所有承载脉冲电流的连线必须非常短，并尽可能宽。由于大电流 di/dt ，这些引线的电感必须保持在最小值。由于电流承载环路的电感与环路的闭合面积成比例，缩小环路面积有助于减小寄生电感。此外，减小电流环路的面积有助于降低EMI辐射。

输入滤波陶瓷电容应尽量靠近IC的 V_{IN} 引脚，尽可能消除布线电感的影响，为IC提供干净的电源。 V_{CC} 引脚的旁路电容也要靠近引脚放置，以减小引线阻抗的影响。

在IC周围布线时，模拟小信号地和开关电流的功率地应隔离开；应该在开关信号最低的位置将其连接在一起，通常是 V_{CC} 旁路电容的返回点，以保证模拟地不受大功率开关信号的影响。应尽量保证接地区域连续/不中断。不要在任何非连续接地区的正上方布设承载大开关电流的引线。

PCB布局也影响器件的热性能。应在器件的裸焊盘下方提供大面积覆铜，通过多个过孔接至大面积地层，以有效散热。

为确保设计的一次通过率，请参考MAX17505评估板布局，可从以下网站下载：www.maximintegrated.com/cn。

典型应用电路

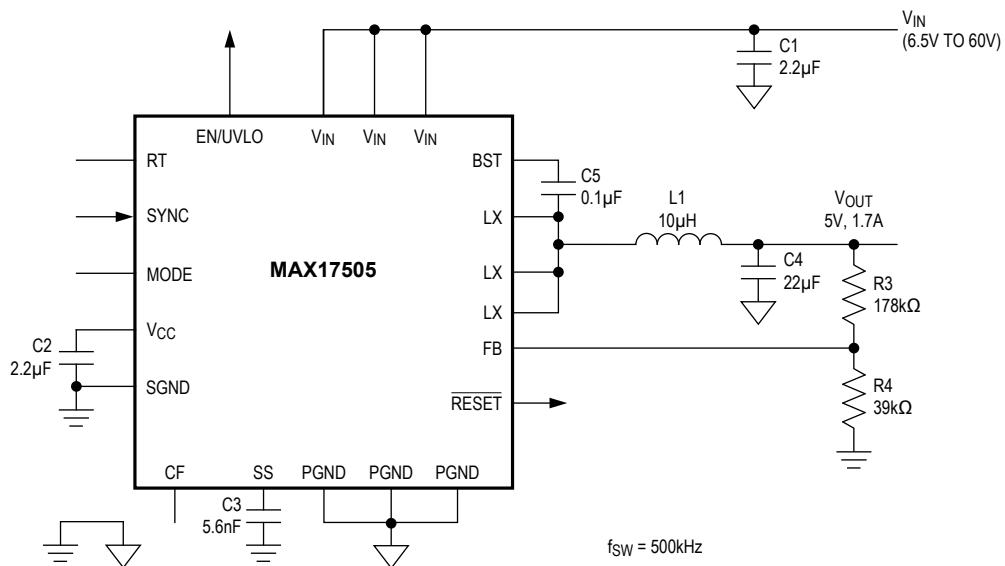


FIGURE 3

MAX17505

4.5V-60V、1.7A、
高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

典型应用电路(续)

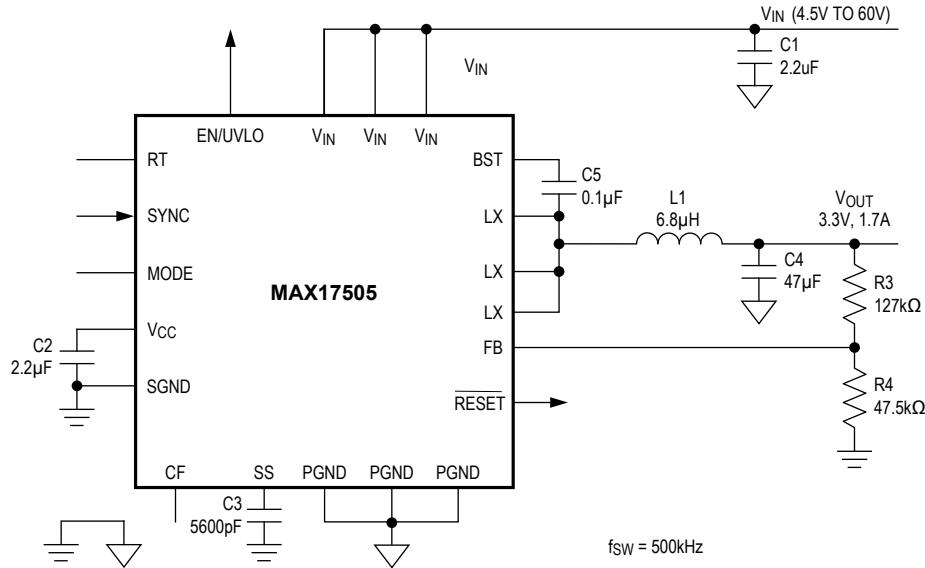


FIGURE 4

定购信息

器件	引脚-封装
MAX17505ATP+	20 TQFN (4mm x 4mm)

注：除非另外说明，器件工作在-40°C至+125°C温度范围。

+表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装。

*EP = 裸焊盘。

芯片信息

PROCESS: BiCMOS

封装信息

如需最近的封装外形信息和焊盘布局(占位面积)，请查询www.maximintegrated.com/cn/design/packaging。请注意，封装编码中的“+”、“#”或“-”仅表示RoHS状态。封装图中可能包含不同的尾缀字符，但封装图只与封装有关，与RoHS状态无关。

封装类型	封装编码	外形编号	焊盘布局编号
20 TQFN-EP	T2044+4	21-0139	90-0409

MAX17505

4.5V-60V、1.7A、
高效同步降压型DC-DC转换器，内部补偿

修订历史

修订号	修订日期	说明	修改页
0	1/14	最初版本。	—

Maxim北京办事处

免费电话：800 810 0310

电话：010-5226 4200

传真：010-6211 5299



Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。电气特性表中列出的参数值(最小值和最大值)均经过设计验证，数据资料其它章节引用的参数值供设计人员参考。

Maxim Integrated 160 Rio Robles, San Jose, CA 95134 USA 1-408-601-1000

© 2014 Maxim Integrated

Maxim标志和Maxim Integrated是Maxim Integrated Products, Inc.的商标。